

# RF POWER FIELD-EFFECT TRANSISTOR

**DESCRIPTION:**

The **ASI MRF137** is a N-Channel Enhancement MOSFET, Designed for Wideband Large Signal Output and Driver Stage Applications up to 400 MHz.

**MAXIMUM RATINGS**

<b>I<sub>D</sub></b>	5.0 A
<b>V<sub>DSS</sub></b>	65 V
<b>P<sub>DISS</sub></b>	100 W @ T <sub>C</sub> = 25 °C
<b>T<sub>J</sub></b>	-65 °C to +200 °C
<b>T<sub>STG</sub></b>	-65 °C to +150 °C
<b>θ<sub>JC</sub></b>	1.75 °C/W

**PACKAGE STYLE .380 4L FLG**

1 = DRAIN    2 = GATE  
3 & 4 = SOURCE

	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	.220/5,59	.230/5,84
B	.785/19,94	
C	.720/18,29	.730/18,54
D	.970/24,64	.980/24,89
E		.385/9,78
F	.004/0,10	.006/0,15
G	.085/2,16	.105/2,67
H	.160/4,06	.180/4,57
I		.280/7,11
J	.240/6,10	.255/6,48

**CHARACTERISTICS** T<sub>C</sub> = 25 °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS		MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
<b>V<sub>(BR)DSS</sub></b>	I <sub>D</sub> = 10 mA	V <sub>GS</sub> = 0 V	65			<b>V</b>
<b>I<sub>DSS</sub></b>	V <sub>DS</sub> = 28 V	V <sub>GS</sub> = 0 V			4.0	<b>mA</b>
<b>I<sub>GSS</sub></b>	V <sub>DS</sub> = 0 V	V <sub>GS</sub> = 20 V			1.0	<b>μA</b>
<b>V<sub>GS(th)</sub></b>	I <sub>D</sub> = 25 mA	V <sub>DS</sub> = 10 V	1.0	3.0	6.0	<b>V</b>
<b>g<sub>fs</sub></b>	I <sub>D</sub> = 500 mA	V <sub>DS</sub> = 10 V	500	750		<b>mmhos</b>
<b>C<sub>iss</sub></b> <b>C<sub>oss</sub></b> <b>C<sub>rss</sub></b>	V <sub>DS</sub> = 28 V	V <sub>GS</sub> = 0 V		48 11	45	<b>pF</b>
<b>NF</b>	V <sub>DS</sub> = 28 V	I <sub>D</sub> = 1.0 A		1.5		<b>dB</b>
<b>G<sub>ps</sub></b> <b>η</b>	V <sub>DD</sub> = 28 V I <sub>DQ</sub> = 25 mA	P <sub>out</sub> = 30 W	12 50	16 60		<b>dB</b> <b>%</b>
<b>ψ</b>	V <sub>DD</sub> = 28 V I <sub>DQ</sub> = 25 mA	P <sub>out</sub> = 30 W VSWR 30:1 @ ALL PHASE ANGLES				NO DEGRADATION IN OUTPUT POWER



f (MHz)	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>	
	S <sub>11</sub>	φ	S <sub>21</sub>	φ	S <sub>12</sub>	φ	S <sub>22</sub>	φ
2	0.977	-32	59.48	163	0.011	67	0.661	-36
5	0.919	-70	48.67	142	0.024	44	0.692	-78
10	0.852	-109	33.50	122	0.032	29	0.747	-117
20	0.817	-140	19.05	106	0.037	16	0.768	-146
30	0.814	-153	13.11	99	0.038	14	0.774	-157
40	0.811	-159	9.88	95	0.038	13	0.782	-162
50	0.812	-164	7.98	92	0.038	12	0.787	-165
60	0.813	-166	6.66	89	0.038	12	0.787	-168
70	0.815	-168	5.708	86	0.038	11	0.787	-169
80	0.816	-170	5.003	84	0.038	11	0.787	-170
90	0.817	-171	4.560	83	0.038	12	0.787	-171
100	0.817	-172	4.170	81	0.039	13	0.787	-172
110	0.818	-173	3.670	80	0.039	13	0.788	-172
120	0.820	-173	3.420	79	0.039	13	0.788	-173
130	0.821	-173	3.170	79	0.039	13	0.788	-173
140	0.822	-174	2.980	78	0.039	13	0.788	-173
150	0.823	-175	2.826	77	0.039	14	0.788	-173
160	0.824	-175	2.650	76	0.039	14	0.790	-174
170	0.825	-176	2.438	75	0.039	14	0.792	-174
180	0.827	-176	2.325	73	0.039	15	0.793	-174
190	0.829	-177	2.175	72	0.039	16	0.796	-174
200	0.831	-177	2.084	71	0.039	16	0.799	-174
225	0.836	-178	1.824	69	0.039	18	0.805	-174
250	0.846	-178	1.621	66	0.039	21	0.816	-174
275	0.853	-179	1.462	64	0.039	23	0.822	-174
300	0.853	-179	1.319	61	0.040	25	0.833	-174
325	0.856	-179	1.194	59	0.040	27	0.828	-174
350	0.857	+ 179	1.089	56	0.040	30	0.842	-174
375	0.861	+ 179	1.014	54	0.042	32	0.849	-174
400	0.865	+ 178	0.927	51	0.043	35	0.856	-174
425	0.875	+ 178	0.876	49	0.045	37	0.866	-174
450	0.881	+ 178	0.810	46	0.046	40	0.870	-174
475	0.886	+ 177	0.755	44	0.046	43	0.875	-174
500	0.887	+ 177	0.694	41	0.051	43	0.888	-174
525	0.888	+ 176	0.677	39	0.052	43	0.890	-174
550	0.896	+ 176	0.625	36	0.055	45	0.898	-174
575	0.907	+ 175	0.603	34	0.058	45	0.913	-174
600	0.910	+ 175	0.585	32	0.061	45	0.918	-174
625	0.910	+ 174	0.563	30	0.065	45	0.945	-174
650	0.920	+ 174	0.543	28	0.069	46	0.952	-174
675	0.938	+ 173	0.533	26	0.074	47	0.974	-174
700	0.943	+ 171	0.515	24	0.078	47	0.958	-176
725	0.934	+ 170	0.491	22	0.079	46	0.953	-177
750	0.940	+ 170	0.475	22	0.084	48	0.943	-177
775	0.953	+ 169	0.477	21	0.090	48	0.957	-177
800	0.959	+ 168	0.467	17	0.093	48	0.957	-179

Common Source Scattering Parameters  
50 Ω System  
VDS = 28 V, ID = 0.75 A

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9